# $\begin{array}{c} {\bf Digital elektronisches\ Praktikum} \\ {\bf Versuch\ 5} \end{array}$

 $\label{eq:moritz_breipohl} Moritz \ Breipohl\\ \textit{mbreipohl@techfak.uni-bielefeld.de}$ 

 ${\it Markus~Rothg\"{a}nger} \\ {\it mrothga} {\it enger@techfak.uni-bielefeld.de}$ 

Gruppe 5

Tutor: Lukas Schmidt, Robin Ewers

20. Juni 2018

## Versuchsaufbau

#### Aufgabe

Im fünften Versuch sollten zwei verschiedene CMOS-Logikgatter mit mindestens zwei Eingängen sowohl simuliert als auch auf dem Steckbrett aufgebaut werden. Zur Untersuchung der Schaltung sollte das erwartete Verhalten anhand einer Logiktabelle mit dem gemessenen Verhalten verglichen werden. Des weiteren sollte die Schaltung durch eine integrierte Schaltung realisiert werden. Schließlich sollten alle Schaltungen auf ihre Verzögerungszeit und die Stromaufnahme untersucht werden.

#### Erwartung

Die generelle Erwartung ist, dass alle Gatter-Aufbauten ein gleiches Logikverhalten aufweisen. Aus den letzten Versuchen abgeleitet ist eine teils hohe Abweichung zwischen realen und simulierten Messungen in Bezug auf die Verzögerungszeit und die Stromaufnahme zu erwarten. Dennoch ist auch eine Abweichung der Messwerte von integriertem Schaltkreis (auch IC (integrated Circuit)) und dem aus transistoren aufgebauten Gatter möglich.

#### Aufbau

Es wurden ein NAND- und ein NOR-Gatter untersucht. Beide Aufbauten sind für den Simulator und das Steckbrett identisch. Zu beachten ist, dass die Messpunkte für die Ausgangsspannung  $(U_{OUT})$  und den statischen Querstrom  $(I_{quer})$  in den Schemata eingezeichnet sind. Hier wurden dann Multimeter Spannungs- bzw. Stromrichtig angeschlossen. Der Aufbau des NAND-Gatters ist in Abbildung 1 dargestellt, der des NOR-Gatters in Abbildung 2. Die beiden Eingangsspannungen  $(U_{IN1}$  und  $U_{IN2})$  wurden zeitweise über entprellte Taster, sowie über den Funktionsgenerator bedient. Zur Messung der Verzögerungszeit wurde außerdem die Ausgangsspannung  $U_{OUT}$  mithilfe des Oszilloskopes betrachtet. Mit gleicher Handhabung zum Messen wurden die Schaltungen mit Hilfe von ICs aufgebaut. Diese Aufbauten am Steckbrett sind in Abbildung 3 (NAND) und Abbildung 4 (NOR) zu sehen.

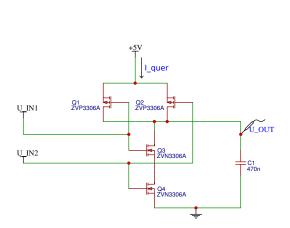


Abbildung 1: Aufbau des NAND-Gatters

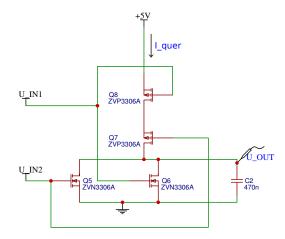
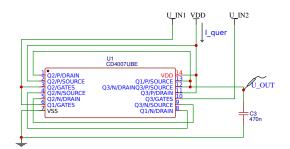
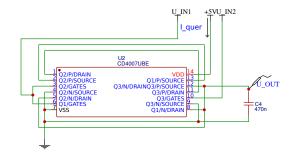


Abbildung 2: Aufbau des NOR-Gatters

Gruppe 5 2 von 5





**Abbildung 3:** Aufbau des NAND-Gatters mit IC

Abbildung 4: Aufbau des NOR-Gatters mit IC

#### Verwendete Bauteile

Multimeter, ein Strombegrenztes Versorgungsnetzteil mit einer konstanten Spannung von 5V, jweils zwei Transistoren vom Typ ZVN3306a sowie vom Typ ZVP3306a, ein Kondensator mit einer Kapazität von 470nF, Funktionsgenerator und Oszilloskop, IC vom Typ CD4007UB.

# Durchführung

#### Verifizierung des Logikverhaltens

Die Auswirkungen jeder Eingangskombination auf die Ausgangsspannung wurde hier geprüft. Dabei wurden die Eingäng über entprellte Schalter angesteuert, welche an einem Netzteil mit 5V Versorgungsspannung angeschlossen waren. Am Ausgang der Schaltung befand sich eine LED, über deren Status (leuchtet oder leuchtet nicht) geprüft werden konnte, ob die Schaltung den Stromfluss zum Ausgang erlaubt.

#### Messung des statischen Querstroms

Zur Messung des Querstroms wurde am Steckbrett ein Amperemeter in Reihe in den Versorgungsstromkreis geschaltet. Die Versorgungsspannung lag bei konstanten  $U_{VDD}=5V$  mit einer Strombegrenzung von etwa I=0.2A. Es war darauf zu achten, dass während der Strommessung kein Schaltvorgang durchgeführt wurde, da sonst der dynamische statt dem statischen Querstrom gemessen würde. In der Simulation wurde die Stromaufnahme an der Spannungsquelle gemessen.

#### Messung der Verzögerungszeit

Am Steckbrett wurde das Oszilloskop genutzt, um einen oder beide Eingänge mit einer vom Funktionsgenerator generierten Kurve zu versorgen. Die Eingangskurve sowie der Spannungsverlauf am Ausgang wurden vom Oszilloskop aufgenommen und die Verzögerungszeit für die steigende als auch die abfallende Flanke mithilfe der Cursor bestimmt.

Ähnlich wurde die Verzögerungszeit in der Simulation bestimmt. Die beiden Eingänge wurden als pulsierende Spannungsquellen definiert, die eine unterschiedlichen Rythmus

Gruppe 5 3 von 5

# Messergebnisse

### Logikverhalten

vier logiktabellen (inkl. erwartung)

Input A	Input B	Erwartetes Ergebnis	eigene Schaltung	IC	Simulation
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0

Tabelle 1: Logikverhalten der NOR Gatter

Input A	Input B	Erwartetes Ergebnis	eigene Schaltung	IC	Simulation
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0

Tabelle 2: Logikverhalten der NAND Gatter

### Querströme

je schaltung eine tabelle die den Strom der konfigurationenen (sim, steckbrett, ic) aufzeigt.

	Querstrom [µA]
Selbstgbaut	5.06
IC	224.6
Simulation	0

Tabelle 3: statischer an den NOR Gattern

	Querstrom [µA]
Selbstgbaut	260
IC	60
Simulation	0

Tabelle 4: statischer Querstrom an den NAND Gattern

#### Verzögerungszeiten

Da die Verzögerungszeiten für beide Eingänge sehr ähnlich bzw. gleich waren, werden hier der Übersicht halber nur die Messergebnisse für die Veränderung des Zustands eines Eingangs aufgezeigt.

Gruppe 5 4 von 5

	Flanke steigend [µS]	Flanke fallend [µS]
Selbstgbaut	2.9	19.6
$\operatorname{IC}$	232	1520
Simulation	4.98	39.05

Tabelle 5: Verzögerungszeiten an den NOR Gattern

	Flanke steigend [µS]	Flanke fallend [µS]
Selbstgbaut	5.6	7.9
IC	710	130
Simulation	8.94	11.93

Tabelle 6: Verzögerungszeiten an den NAND Gattern

# Auswertung

erwartung erfüllt? vergleich von steckbrett und ic

Gruppe 5 5 von 5